



Question Paper

B.Sc. General Examinations 2022

(Under CBCS Pattern)

Semester - VI

Subject : ELECTRONICS

Paper : DSE 1B/2B/3B-T

Full Marks : 40 Time : 2 Hours

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.

Mathematics Foundation for Electronics

1. Answer any *four* questions. Each question carries five marks : $5 \times 4=20$

(i) Illustrate the Cayley-Hamilton theorem for the matrix A, where

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5

(ii) Using Cauchy's Integral formula, evaluate

$$\int_{c} \frac{e^{2z} dz}{(z-1)(z-2)}$$
 where c is the circle, $|z| = 3$ 5

(iii) Solve (3y + 2x + 4) dx - (4x + 6y + 5) dy = 0

5

(iv) Determine whether the matrix
$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$
 is orthogonal or not. 5

(v) State and prove the convolution theorem in Laplace transform. 2+3

(vi) Examine the character of the series

(a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{2n-1}$$
 (b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n(n-1)}$; $0 < x < 1$ $2^{\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}}$

2. Answer any *two* questions. Each question carries ten marks :

(i) (a) State Cauchy's integral theorem in complex variable analysis and apply the Cauchy-Riemann contition to prove it.

(b) If w = log z, find
$$\frac{dw}{dz}$$
 and determine where w is non-analytic. (2+4)+2+2

 (ii) Write down the Taylor's expansion of any analytic function f(z) in a complex plane and accordingly prove it. 3+7

(iii) (a) Find the inverse Laplace transform of
$$\frac{2s^2 - 6s + 5}{s^3 - 6s^2 + 11s - 6}$$
.

(b) Find the Laplace transform of $t^2 \sin at$.

(iv) Find the eigen values and eigen vectors of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. 5+5

বঙ্গানুবাদ

১. যেকোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ ৫×৪=২০

(i) ম্যাট্রিক্স A-এর জন্য Cayley-Hamilton theorem বিবৃত কর, যেখানে
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 ৫

6+4

 $10 \times 2 = 20$

(ii) Cauchy's Integral ফর্মুলা ব্যবহার করে
$$\int_{a}^{a} \frac{e^{22}dz}{(z-1)(z-2)}$$
-এর মান নির্ণয় কর, যেখানে c একটি বৃত্ত, $|z| = 3$.
(iii) সমাধান কর $(3y + 2x + 4)dx - (4x + 6y + 5) dy = 0$
(iv) ম্যাট্রিঙ্গ $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1\\ 4 & 3 & 1\\ -3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$ orthogonal কি নয়, নির্ধারণ কর।
(v) Laplace transform-4 convolution theorem বিবৃত কর এবং প্রমাণ কর।
(v) Series ওলির প্রকৃতি পরীক্ষা কর।
(v) Series ওলের হের দেরে বিধ্যে ফুল্রে বিধ্যে মূল্যমান ১০ নম্বর ই ১০×২-২০
(i) (ক) Complex variable analysis-ও Cauchy's integral theorem বিবৃত কর এবং এটি প্রমাণ করাতে Cauchy-Riemann condition ব্যবহার কর।
(v) যদি w = log z হয়, $\frac{dw}{dz}$ -এর মান নির্ণয় কর এবং কোথায় w non-analytic হবে নির্ধারণ কর।
(v) বন্দি w = log z হয়, $\frac{dw}{dz}$ -এর মান নির্ণয় কর এবং কোথায় w non-analytic হবে নির্ধারণ কর।
(ii) (ক) $\frac{2s^2 - 6s + 5}{s^3 - 6s^2 + 11s - 6}$ -এর inverse Laplace transform নির্ণয় কর।
(v) t's in at-এর Laplace transform নির্ণয় কর।
(v) ম্যাট্রিঙ্গ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3\\ 1 & 5 & 1\\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ -এর eigen value এবং eigen vector-গুলি নির্ণয় কর।
(iv) ম্যাট্রিঙ্গ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3\\ 1 & 5 & 1\\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ -এর eigen value এবং eigen vector-গুলি নির্ণয় কর।
(iv) ম্যাট্রিঙ্গ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3\\ 1 & 5 & 1\\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ -

Or, Paper - DSE 1B-T C Programming and Data Structures

	e riogianining and Data Structures	
Full M	larks : 40 T	ime : 2 Hours
1. An	swer any <i>four</i> questions. Each question carries five marks :	5×4=20
(i)	Discuss the concept nested if with example.	5
(ii)	What are the prerequisites of binary search and how it is different from	n linear search? 2+3
(iii)	Write down the difference between call by value and call by reference	e with example. 5
(iv)	What is function? Why it is required?	21/2+21/2
(v)	What is binary search tree? Give example.	3+2
(vi)	Explain the best and worst case time complexity of Quick Sort.	5
2. An	swer any two questions. Each question carries ten marks :	10×2=20
(i)	Explain different types of loops used in C Programming. Write down between break and continue.	n the difference 8+2
(ii)	Explain circular queue with its operations.	10
(iii)	What is an array? Write down its syntax. Write a program using a minimum and maximum number from the array.	rray to find the 2+2+6
(iv)	Explain the algorithm of merge sort with example.	10
	বঙ্গানুবাদ	
১. যে	কান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ	&×8=ઽ੦
(i)	উদাহরণ সহ নেস্টেড লুপ এর সম্পর্কে আলোচনা কর।	¢
(ii)	বাইনারি সার্চের পূর্বশর্তগুলি কী এবং কীভাবে ইহা লিনিয়ার সার্চ থেকে আলাদা?	2+O

(iii)	উদাহরণ সহ কল বাই ভ্যালু এবং কল বাই রেফারেন্স-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।	Č
(iv)	ফাংশন কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা কী?	<u> کې</u> +کې
(v)	বাইনারি সার্চ ট্রি কি? উদাহরণ দাও।	৩+২
(vi)	কুইক সর্ট এর Best Case ও Worst case time complexity সম্পর্কে বর্ণনা কর।	¢
২. যে	কান দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ১০ নম্বর ঃ	১০×২=২০
(i)	সি প্রোগ্রামিং-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের লুপ সম্পর্কে বর্ণনা কর। Break এবং Contin পার্থক্য লিখ।	nue এর মধ্যে ৮+২
(ii)	Circular Queue এর বিভিন্ন function গুলি ব্যাখ্যা কর।	20
(iii)	অ্যারে কি? ইহার সিনট্যাক্স লিখ। অ্যারের মধ্যে থেকে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা বের ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখ।	করতে অ্যারে ২+২+৬
(iv)	উদাহরণ সহ মার্জ সর্ট অ্যালগরিদম ব্যাখ্যা কর।	20
	idias	

)

Or, Paper - DSE 1B-T Computer Networks

	Computer Networks	
Full M	arks : 40	Time : 2 Hours
1. Ans	swer any <i>four</i> questions. Each question carries five marks :	5×4=20
(i)	Discuss point to point and multipoint connection.	5
(ii)	Explain CRC as error detection and correction code.	5
(iii)	Describe the circuit switching technique.	5
(iv)	Explain Nyquist theorem.	5
(v)	Discuss token bus LAN.	5
(vi)	Why hubs are used as network devices?	5
2. An	swer any two questions. Each question carries ten marks :	10×2=20
(i)	Describe the layers of OSI model.	10
(ii)	Discuss about guided and unguided media.	10
(iii) What is meant by network topology? Discuss different types of network topologies.		
		2+8
(iv)	What is WWW? Discuss domain name system.	4+6
	বঙ্গানুবাদ	
১. যে	কান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্বের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ	&×8=₹0
(i)	পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং মাল্টিপয়েন্ট সংযোগ নিয়ে আলোচনা কর।	Č
(ii)	ত্রুটি সনাক্তকরণ এবং সংশোধন কোড হিসাবে CRC ব্যাখ্যা কর।	Č
(iii)	সার্কিট সুইচিং কৌশল বর্ণনা কর।	Č
(iv)	Nyquist theorem ব্যাখ্যা কর।	Č

(v)	টোকেন বাস LAN আলোচনা কর।	ć
(vi)	কেন হাব-কে নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসাবে ব্যবহার করা হয়?	ć
২. যে	কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ১০ নম্বর ঃ	১ ০×২=২०
(i)	OSI মডেলের স্তরগুলি বর্ণনা কর।	20
(ii)	গাইডেড ও আনগাইডেড মিডিয়া গুলির সম্পর্কে আলোচনা কর।	20
(iii)	নেটওয়ার্ক টপোলজি বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিগুলি অ	ালোচনা কর। ২+৮
(iv)	WWW কি? ডোমেইন নেম সিস্টেম নিয়ে আলোচনা কর।	8+⊌

Or,

Paper - DSE 1B-T

Nanoelectronics Science and Growth Technologies

Full M	arks : 40 Time : 2 H	lours
1. An	swer any <i>four</i> questions. Each question carries five marks : 5>	<4=20
(i)	Explain meso, mirco and nano domains. What is Moore's empirical law?	3+2
(ii)	What is a hetrojunction? Describe the formation of a superlattice structure.	2+3
(iii)	What do you mean by 'DOS'? Compare the 'DOS' of 2D, 1D and 0D materials.	2+3
(iv)	Mention the properties of carbon nanotubes. Indicate two important application carbon nanotubes.	ons of 3+2
(v)	Define class 10 clean room.	
	If we expose a 200-mm wafer for 1 minute to air-steam under a laminar condition at 30 m/min, how many dust particle will land on the wafer in cla clean room?	flow ass 10 2+3
(vi)	Explain dry and wet oxidation. 2 ¹ /	2+2 ¹ /2
2. Ar	swer any <i>two</i> questions. Each question carries ten marks : 10>	<2=20
(i)	(a) Explain quantum well, quantum wire and quantum dot structures.	
	(b) What is quantum confinement? Write down the condition for quantum confinement in a quantum well. $(2+2+2)+(2+$	antum (2+2)
(ii)	Discuss top-down technique and bottom-up technique.	
	"Bottom-up technique is more convenient for nano fabrication"—Explain. (3-	+3)+4
(iii)	What is lithography? Compare various lithographic methods.	2+8
(iv)	(a) Explain e-beam evaporation process.	
	(b) Describe various stages of PLD process.	5+5

	\mathbf{n}	``
	ч	۱.
•	/	,
•		

	বঙ্গানুবাদ	
১. যে	কান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ	৫ ×8= ২ ০
(i)	মেসো, মাইক্রো এবং ন্যানো অঞ্চলসমূহ ব্যাখ্যা কর। মুরের প্রয়োগিক নী	ত কি? ৩+২
(ii)	বিসম সংযোগ কি? সুপারল্যাটিস্ গঠন বর্ণনা কর।	२ +७
(iii)	'ডিওএস' বলিতে তুমি কি বোঝ? ২ডি, ১ডি এবং ০ডি উপাদানসমূহের 'ডি	ওএস' তুলনা কর। ২+৩
(iv)	কার্বন ন্যানোটিউবের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর। কার্বন ন্যানোটিউবের দুইটি গু কর।	রুত্বপূর্ণ ব্যবহারের উল্লেখ ৩+২
(v)	সংজ্ঞা দাও ঃ ক্লাস ১০ পরিষ্কার কর।	
	২০০ মিমি ওয়েফারকে ৩০ মি/মিনিট লেমিনার বায়ুপ্রবাহে ১ মিনিট ক্লাস করিলে কতগুলি ধূলিকণা ওয়েফারের উপর জমিবে?	১০ পরিষ্কার ঘরে উন্মুক্ত ২+৩
(vi)	শুষ্ক ও সিক্ত জারণ ব্যাখ্যা কর।	$2\frac{5}{2}+2\frac{5}{2}$
২. যে	কান দুটি প্রশের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশের মূল্যমান ১০ নম্বর ঃ	20×5=50
(i)	(i) (ক) কোয়ান্টাম ওয়েল, কোয়ান্টাম ওয়ার এবং কোয়ান্টাম ডট গঠনসমূহ ব্যাখ্যা কর।	
(খ) কোয়ান্টাম বন্দী কি? কোয়ান্টাম ওয়েলের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বন্দীর শর্ত লেখ।		
		(2+2+2)+(2+2)
(ii)	টপ্-ডাউন পদ্ধতি এবং বট্ম-আপ পদ্ধতি আলোচনা কর।	
	"বট্ম-আপ পদ্ধতি ন্যানো গঠনে অনেক সুবিধাজনক"—ব্যাখ্যা কর।	8+(@+@)
(iii)	লিথোগ্রাফি কি? লিথোগ্রাফির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তুলনা কর।	2+6
(iv)	(ক) 'ঈ-বিম' বাষ্পীভবন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।	
	(খ) 'পি-এল-ডি' পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়গুলি বর্ণনা কর।	\$+\$

Or, Paper - DSE 1B-T Electronic Instrumentation

Full M	larks : 40	Time : 2 Hours
1. Ans	swer any <i>four</i> questions. Each question carries five marks :	5×4=20
(i)	Define accuracy and precision of a system. What is electromag	netic interference? $(1\frac{1}{2}+1\frac{1}{2})+2$
(ii)	Write down the operating principle of Anderson's bridge.	5
(iii)	Define line and load regulations.	21/2+21/2
(iv)	Write advantages of SMPS over linear power supply.	5
(v)	Draw complete block diagram of a power supply and explain eac	h of the block. 5
(vi)	Differentiate between active and passive transducer.	5
2. An	swer any <i>two</i> questions. Each question carries ten marks :	10×2=20
(i)	Write basic principle of phase locked loop (PLL). Write its advantag	es and applications. 6+(2+2)
(ii)	Draw block diagram of a function generator. Explain each of the b	vlock. 4+6
(iii)	Write short note on semiconductor strain gauge.	10
(iv)	Draw block diagram of CRT and explain its operating principle.	4+6
	বঙ্গানুবাদ	
১. যে	কান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ	৫×8=২০
(i)	একটি সিস্টেমের accuracy এবং precision এর সংজ্ঞা দাও। Electromagneti	c interference কাকে
	বলে ?	$(2\frac{5}{5}+2\frac{5}{5})+2$
(ii)	Anderson's bridge এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।	¢

1	1 1	`
(

(iii)	Line এবং load regulation এর সংজ্ঞা দাও।	$2\frac{5}{2}+2\frac{5}{2}$
(iv)	SMPS এর উপকারিতা সম্পর্কে লেখ যেটা linear power supply এ পাওয়া যায় না	¢
(v)	Power supply unit এর পুরো ব্লক চিত্রটি অঙ্কন কর এবং প্রত্যেক ব্লকের সম্পর্কে বর্ণ	না কর। ৫
(vi)	একটিভ এবং প্যাসিভ ট্রান্সডিউসারের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখ।	¢
২. যে	কোন দুটি প্রশের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশের মূল্যমান ১০ নম্বর ঃ	১০×২=২০
(i)	Phase locked loop এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। এর উপকারিতা এবং কার্যকারিতা ব	উল্লেখ কর। ৬+(২+২)
(ii)	Function generator এর ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকো এবং প্রত্যেক ব্লকের বর্ণনা কর।	8+&
(iii)	সেমিকনডাকটার স্ট্রেন গেজ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।	20
(iv)	CRT এর ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকো এবং এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।	8+&

Or,
Paper - DSE 1B-T
Photonic Devices and Power Electronics

Full M	Time : 2 Hours		
1. Answer any <i>four</i> questions. Each question carries five marks : $5 \times 4=20$			
(i)	Discuss the various types of power electronics converters.	5	
(ii)	Discuss the transfer and output characteristics of power MOSFETs	$2^{1/2}+2^{1/2}$	
(iii)	Compare between an IGBT and a PMOSFET.	5	
(iv)	Calculate the carrier frequencies for optical communication system μ m, 1.3 μ m and 1.55 μ m. What is the photon energy in each case	$\begin{array}{l} \text{as operating at } 0.88 \\ \text{?} \qquad 2 + (1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}) \end{array}$	
(v)	What are the contributing factors for losses in fiber optics? Draw the single mode fiber.	ne loss spectrum of 2+3	
(vi)	Compare diode with a thyristor.	5	
2. Answer any <i>two</i> questions. Each question carries ten marks : $10 \times 2=20$			
(i)	Describe the switching characteristic of power MOSFET. Compa- BJT.	re MOSFETs with 5+5	
(ii)	Describe methods to describe the $\frac{di}{dt}$ and $\frac{dv}{dt}$ rating of thyriston	or. 10	
(iii)	Describe briefly the following members of thyristors, SUS, SC	S, and PUT. 10	
(iv)	Derive an expression for the quantum efficiency of photodetect	tor. 10	
বঙ্গানুবাদ			
১. যেকোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্নের মূল্যমান ৫ নম্বর ঃ ৫×৪=২০			
(i)	বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কনর্ভারটার সম্পর্কে আলোচনা কর।	Č	
(ii)	MOSFET এর ট্রান্সফার ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর।	$2\frac{5}{2}+2\frac{5}{2}$	

(iii)	IGBT এবং PMOSFET এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।	¢
(iv)	একটি অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যাবস্থা কাজ করছে 0.88 µm, 1.3µm এবং 1.55	µm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে।
	এদের ক্যারিয়ার কম্পাঙ্ক কত? প্রত্যেকের ফোটন শক্তি কত?	$\lambda + (\lambda \frac{\lambda}{2} + \lambda \frac{\lambda}{2})$
(v)	অপটিক্যাল ফাইবারের শক্তি ক্ষয়ের কারণগুলি কি? সিঙ্গল মোড ফাইবারের লস সে	প্পকট্রামটি আঁকো। ২+৩
(vi)	ডায়োড ও থাইরিস্টারের মধ্যে তুলনা কর।	Č
২. যেন্	কান দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেক প্রশ্বের মূল্যমান ১০ নম্বর ঃ	১০×২=২০
(i)	পাওয়ার MOSFET এর ইলেকট্রনিক সুইচ এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। MOSFET তুলনা কর।	ও BJT এর মধ্যে ৫+৫
(ii)	থাইরিস্টারের $rac{\mathrm{di}}{\mathrm{dt}}$ ও $rac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dt}}$ রেটিং কি তাহা ব্যাখ্যা কর।	20
(iii)	থাইরিস্টার পরিবারের নিচের ডিভাইসগুলি সম্পর্কে যাহা জান লেখ।	
	SUS, SCS, PUT	20
(iv)	ফটোডিটেক্টারের কোয়ান্টাম কার্যকারিতার একটি গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।	20